МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фізичний факультет

Кафедра загальної фізики

На правах рукопису

**Кінетика фотоелектричних параметрів кремнієвих сонячних елементів, викликана перебудовою пар FeB**

**Галузь знань:** 10 Природничі науки

**Спеціальність**: 104 Фізика та астрономія

**Освітня програма:** Фізика та астрономія

**Кваліфікаційна робота бакалавра**

студента 4 курсу

Іван КУЩ

**Науковий керівник**:

доктор фізико-математичних наук,

професор, професор кафедри загальної фізики

Олег ОЛІХ

Робота заслухана на засіданні кафедри загальної фізики та рекомендована до захисту на ЕК, протокол №\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

Завідувач кафедри загальної фізики проф. Микола БОРОВИЙ

Київ – 2023

**ВИТЯГ**

з протоколу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

засідання Екзаменаційної комісії

Визнати, що студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ виконав та захистив кваліфікаційну роботу бакалавра з оцінкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голова ЕК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.

**АНОТАЦІЯ**

**Шатлик ІЛАМАНОВ.** Кінетика фотоелектричних параметрів кремнієвих сонячних елементів, викликана перебудовою пар FeB

*Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, освітня програма «Фізика та астрономія». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ – 2023.*

**Науковий керівник**: доктор фізико-математичних наук, професор Олег ОЛІХ, професор кафедри загальної фізики.

Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація

**Ключові слова**: ключові слова.

**SUMMARY**

**Shatlik ILAMANOV.** Kinetics of photoelectric parameters of silicon solar cells caused by the rebuilding of FeB pairs.

*Bachelor qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational program «Physics and astronomy». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, General Physics Department. – Kyiv. – 2023*.

**Research supervisor**: Doctor of Physicі and Mathematics, Professor Oleg OLIKH, Professor at General Physics Department.

Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

**Key words**: key words.

**ЗМІСТ**

[ВСТУП 4](#_Toc132138471)

[Розділ 1. Огляд літератури 6](#_Toc132138472)

[1.1. 6](#_Toc132138473)

[1.2. 6](#_Toc132138474)

[1.3. 6](#_Toc132138475)

[Розділ 2. Методика роботи 7](#_Toc132138476)

[2.1 Експериментальна установка та зразки 7](#_Toc132138477)

[2.2 Засади моделювання кінетики фотоелектричних параметрів 9](#_Toc132138478)

[Розділ 3. Отримані результати 12](#_Toc132138479)

[3.1 Результати моделювання 12](#_Toc132138480)

[3.2 Результати експериментального дослідження 14](#_Toc132138481)

[Висновки 15](#_Toc132138482)

[Список використаних джерел 16](#_Toc132138483)

[Додаток 1. Лістинг програми, що записується у мікроконтроллер **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc132138484)

# ВСТУП

Сонячні елементи, або сонячні панелі, є одними з найбільш перспективних альтернативних джерел енергії на теперішній час. Вони забезпечують чисту та відновлювальну енергію, що стає все більш актуальним у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації у світі. За останні роки, розвиток технологій сонячної енергетики набув величезного імпульсу, що дозволило знизити вартість сонячних панелей та зробило їх доступними для більш широкого кола споживачів.

Незважаючи на величезний потенціал сонячних панелей, на жаль, існують і певні труднощі пов’язані з їхнім використанням. Зокрема, кремнієві сонячні елементи (КСЕ) мають і свої недоліки, які впливають на їх ефективність фотоелектричного перетворення та тривалість роботи. Один із головних проблем - дефекти в КСЕ, які можуть виникнути в процесі їх виробництва, зберігання та експлуатації. Відомо, що кожен матеріал містить дефекти; ідеальних систем просто не існує. Хоча для створення дефекту може знадобитися енергія, збільшення конфігураційної ентропії при появі відхилень від періодичності сприяє появі певної концентрація дефектів, оскільки це знижує вільну енергія системи. Тому навіть у рівновазі можна очікувати наявності дефектів; а кінетичні обмеження іноді призводять до утворення додаткових дефектів. Зауважимо, що ці міркування не стосуються домішок, які неконтрольовано з’являються під час вирощування кристалів або подальшої обробки. Крім того, домішки часто вводяться навмисно з метою модифікації властивостей матеріалів. Так легування напівпровідників акцепторами і донорами має важливе значення для мікроелектронних пристроїв. Надалі ми будемо використовувати слово «дефект» як загальний термін для позначення як власних дефектів, так і домішкових.

Оскільки дефекти неминучі, необхідно враховувати їхній вплив на властивості матеріалів. Ці ефекти можуть бути значними, аж до визначення функціональності матеріалу. Наприклад, точкові дефекти відіграють ключову роль у процесі дифузії; нерідко дефекти є причиною деградації пристрою. Проте навіть за відсутності деградації дефекти можуть обмежити продуктивність пристрою.

Вивчення дефектів кремнієвих сонячних елементів є важливим кроком для подальшого розвитку сонячної енергетики та покращення її ефективності. Розуміння причин виникнення дефектів вивчення їхніх властивостей допоможуть збільшити ефективність та тривалість роботи сонячних панелей, що сприятиме збереженню навколишнього середовища.

В сонячних елементах загалом зустрічається значна кількість різноманітних дефектів. Наприклад, одними з найпоширеніших з них у КСЕ є мікротріщини. Вони можуть виникнути в процесі виробництва, транспортування або монтажу сонячних панелей. Мікротріщини знижують ефективність сонячних панелей та можуть привести до їх відмови. Металеві прицепітати та дислокації які з'являються під час процесу формування контактів на поверхні сонячних елементів. Їхня поява викликає суттєве підсилення рекомбінаційних процесів та зниження ефективності сонячних панелей, а також може спричинити їхнє повне виведення з ладу. Крім того, так як здешевлення виробництва вимагає спрощення технологічних операцій, у кремній, який використовується у сонячній енергетиці, як правило наявна значна кількість різноманітних домішок, таких як атоми вуглецю, кисню, різноманітних металів. Так, відомо, що у КСЕ однією з найбільш поширених та шкідливих металевих домішок є залізо. Міжвузлові атоми заліза та пари залізо-акцепторна домішка є надзвичайно активними рекомбінаційними центрами, що суттєво впливають на параметри фотоелектричного перетворення. Як наслідок, питання визначення наявної концентрації заліза є надзвичайно важливим. Існуючі широковживані методи (інфрачервона Фур’є спектроскопія, електронно-парамагнітний резонанс, вимірювання часу життя неосновних носіїв заряду, нестаціонарна спектроскопія глибоких рівнів тощо) потребують спеціалізованого обладнання та/або орієнтовані та кристали, а не готові сонячні елементи. З іншого боку, перебудова дефектів, що містять залізо легко реалізується на практиці і впливає на фотоелектричні параметри. Тому метою цієї роботи було вивчення кінетики фотоелектричних параметрів КСЕ, викликаних перебудовою пар FeB, а також оцінка можливості використання таких перехідних процесів для визначення концентрації заліза.

# Розділ 1. Огляд літератури

## 1.1.

## 1.2.

## 1.3.

# Розділ 2. Методика роботи

## 2.1 Експериментальна установка та зразки

В роботі визначання фотоелектричних параметрів КСЕ проводилося на основі аналізу світлових ВАХ за методикою, описаною в розділі 1.3. Вимірювання ВАХ здійснювалося за допомогою експериментальної установки, схема якої наведена на рис.2.1.

|  |
| --- |
|  |
| Рис.2.1 Схема експериментальної установки. 1 – камера зі зразком, 2 – блок вимірювання ВАХ, 3 – блок контролю та встановлення температури, 4 – блок освітлення, 5 – комутатор сигналів, 6 – персональний комп’ютер |

Зразок КСЕ розміщувався у екрановану камеру, де підтримувалася постійна температура. Сталість температури досягалася з використанням пропорційно-інтегро-диференційного контроллера: вхідні дані отримувалися від датчика температури HTU21D, який розміщувався на поверхні КСЕ; регулюючими пристроями виступали елементи Пельт’є ТЕС1-12706, що живилися від керованого джерела струму Д30-06-01А. Система дозволяла підтримувати температуру зразка на протязі робочого дня з точністю 0,05 К. В роботі експерименти проводилися при температурі зразка 340 К.

Безпосередні вимірювання ВАХ проводилися за допомогою чотирьох-квадрантного джерела-вимірювача Keitley 2450. Під час вимірювань КСЕ освітлювався монохроматичним світлом, джерелом якого слугував світло-випромінюючий діод SN-HPIR940nm-1W, максимум випромінювальної здатності якого припадає на 940 нм. Під час вимірів температура діоду підримувалася сталою (22°С) з точністю 0,3°С за допомогою резистивного нагрівача та термостату W1209, а живлення з постійною силою струму (45 мА) здійснювалося за допомогою спеціально розробленої схеми з позитивним зворотнім зв’язком та цифровим керуванням. Як показали вимірювання, здійснені за допомогою цифрового вимірювача оптичної потужності та енергії THORLABS PM100D, потужність освітлення зразка за цих умов складала 510 мкВт.

Установка є автоматизованою та має комп’ютерне керування. Узгодження роботи різних частин установки здійснюється комутатора сигналів, реалізованого з використанням мікроконтролерної плати Arduino Mega 2560.

Для світло-індукованої дисоціації пар FeB використовувалась галогенова лампа Osram 64653 HLX ELC (24 В, 250 Вт), живлення якої здійснювалося за допомогою регулюваного джерела ITECH IT6332В. При цьому оптична потужністю освітлення зразка досягали 700 мВт при струмі через лампу 9,1 А.

Експерименти були проведені на зразках КСЕ дифузійно-польового типу, структура яких показана на рис.2.2. Вони були виготовлені з монокристалічних пластин кремнію товщиною 380 мкм, легованих бором з концентрацією близько 1,4⋅1015 см-3. Бор також використовувався для створення ізотипного переходу. Випрямляючий перехід реалізовано внаслідок дифузії фосфору. На фронтальній площині також сформовано два просвітлюючі шари – див.рис. Омічні контакти (суцільний та сітковий) створено шляхом магнетронного розпилення алюмінію. Розмір використаних зразків - 1,52×1,52 см2.

|  |
| --- |
|  |
| Рис.2.2 Схема використаного сонячного елементу. 1 – фронтальний сітчастий електрод (алюміній), 2 – шар Si3N4 (40 нм), 3 – шар SiO2 (30 нм), 4 – індукований *n*++ шар, 5 – дифузійний *n*+ шар (0,7 мкм), 6 – квазінейтральна область бази (380 мкм), 7 – дифузійний *р*+ шар (0,6 мкм), 8 – тиловий суцільний контакт (алюміній) |

## 2.2 Особливості моделювання кінетики фотоелектричних параметрів

Вольт-амперні характеристики кремнієвих сонячних елементів розраховувалися за допомогою програмного пакету одномірного моделювання SCAPS 3.3.10 [1]. При цьому розглядалася структура, максимально наближена до експериментальних зразків, описаних у попередньому параграфі. А саме, розглядалася кремнієва *n*+-*p*-*p*+ система з базою товщиною 380 мкм, що рівномірно легована бором з концентрацією 1,4⋅1015 см-3. Профілі легування *n*+ емітера та тилового *p*+ шару вважалися таким, як це запропоновано використовувати для моделювання КСЕ в роботі [2], причому максимальна концентрація донорів дорівнювала 3⋅1020 см-3, а акцепторів - 4,8⋅1018 см-3.

Вважалося, що причинами рекомбінації носіїв є власна рекомбінація (пов’язана з Оже-процесами та випромінювальна міжзонна), а також рекомбінація Шоклі-Рід-Хола, причому остання відбувається лише на дефектах, пов’язаних з домішковим залізом (міжвузольних атомах Fei та парах FeB), тобто можливою наявністю інших дефектів було знехтувано. Розрахунки проводилися у припущені, що домішкові атоми заліза рівномірно з концентрацією *N*Fe,tot розподілені в базі та *р*+ шарі (впливом на рекомбінацію відповідних дефектів в n-Si можна знехтувати), а співвідношення між концентраціями міжвузольних атомів *N*Fe та комплексів *N*FeВ (*N*Fe + *N*FeВ = *N*Fe,tot) залежить від положення рівня Фермі в конкретній точці структури та від часу після закінчення вимушеної дисоціації пар та її ступеня – див. далі.

Моделювання ВАХ проводилося в діапазоні напруг від 0 до напруги розімкнутого кола з кроком 10 мВ для температури 340 К за припущення, що здійснюється монохроматичне освітлення системи з довжиною хвилі 940 нм (напівширина лінії 5 нм) та потужністю 4⋅10-4 Вт/см2.

На жаль, SCAPS в автоматичному режимі враховує температурні залежності самого загального вигляду лише для досить обмеженого кола параметрів матеріалу. Тому при створенні вихідного файлу для SCAPS, який описує структуру, враховувалися:

- величина і температурна залежність коефіцієнту поглинання світла кремнієм відповідно до даних роботи [3];

- температурна залежність ефективних мас вільних носіїв [4,];

- температурна залежність теплових швидкостей носіїв [5];

- ширина забороненої зони відповідно до формули Пасслера [6];

- звуження забороненої зони внаслідок легування [7];

- температурна залежність густини станів поблизу границь дозволених зон [8];

- рухливості електронів та дірок за теорією Классена [9];

- температурні та концентраційні залежності коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації [10] та коефіцієнтів Оже-рекомбінації [11];

- параметри дефектних рівнів (положення в забороненій зоні, поперечні перерізи захоплення носіїв), пов’язаних з Fei та FeB, відповідно до [12].

Для отримання кінетичних залежностей використовувався наступний підхід. Вважалося, що в певний початковий момент часу *t* = 0 зупиняється процес вимушеної дисоціації пар FeB і проводилося моделювання низки ВАХ, які відповідали різним моментам часу *t*. З кожної ВАХ визначалися величини густини струму короткого замикання Jsc, напруги розімкнутого кола Voc, питомої максимальної вихідної потужності Pm (на одиницю площі елементу) та коефіцієнта форми FF, що дозволяло отримати часові залежності цих параметрів фотоелектричного перетворення.

При цьому використовувалася відома часова залежність концентрації міжвузольних атомів заліза після розпаду пар [13,14]

, (2.1)

де *N*Fe,0 – концентрація міжвузольних атомів, утворених в результаті розпаду; *N*Fe,eq – та частина міжвузольних атомів заліза з *N*Fe,tot, які залишаться неспареними в рівноважному стані, відповідно до [14]:

, (2.2)

де *N*B – концентрація легуючих атомів бору (в нашому випадку в базі ця величина дорівнювала 1,4⋅1015 см-3, в p+ шарі залежала від конкретної точки), 0,582 еВ - енергія зв’язку пари, *EF* – положення рівня Фермі, 0,394 еВ – енергія донорного рівня, пов’язаного з міжвузольним залізом;

τ*ass* – характерний час асоціації комплексу, який залежить від концентрації бору та температури [15,16]:

, (2.3)

де 0,65 еВ – енергія міграції атомів заліза. При моделюванні вважалося, що дисоціація пар може бути неповною, для кількісної характеризації її ступеня використовувався показник η, тобто вважалося, що

. (2.4)

Розрахунки проводилися для різних значень η та *N*Fe,tot.

# Розділ 3. Отримані результати

Насамперед зауважимо, що для апроксимації кінетичних залежностей фотоелектричних параметрів, як модельованих, так і експериментальних, використовувався вираз

, (3.1)

де Х – один з параметрів (Isc, Voc, Pm або FF), АХ – амплітуда зміни параметру внаслідок повного або часткового розпаду пар FeB, τX – характерний час відновлення параметру; *X*eq – величина параметру, що відповідає рівноважному стану утворення пар. Вибір саме такого апроксимаційного виразу зумовлений, насамперед, тим, що за подібним законом відбувається зміна кількості міжвузольних атомів заліза (див. формулу (2.1)) та комплексів залізо-бор.

## 3.1 Результати моделювання

Для системи, описаної в розділі 2.2, було проведено моделювання кінетики змін величин струму короткого замикання, напруги розімкнутого кола, максимальної вихідної потужності та коефіцієнта форми для інтервалу 40-2940 с після закінчення дисоціації пар FeB с кроком 100 с. При цьому розглянуті випадки, коли загальна концентрація домішкових атомів заліза *N*Fe,tot становила 1011, 1012, 1013 та 1014 см-3, а ступінь дисоціації η дорівнювала 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 та 1. Типові отримані результати представлені на рис.3.1. Видно, що перехід заліза з відокремленої міжвузольної позиції у зв’язаний стан з легуючим заміщуючим атомом викликає підвищення всіх фотоелектричних параметрів, тобто у всіх випадках величини AX від’ємні. Це цілком збігається з очікуваннями, так як відомо, що рекомбінаційна активність Fei вища, ніж для комплексу FeB і тому зростання відносної концентрації *N*Fe негативно відбивається на ефективності фотоелектричного перетворення. Загалом, часові залежності змін фотоелектричних параметрів залишаються схожими незалежно від загальної концентрації домішкових атомів і тому на рисунках наведено лише по одному сімейству кривих (які відповідають різним значенням η) для кожної з характеристик фотоелектричного перетворення. На рисунку також наведені апроксимаційні криві, які, як видно, достатньо добре описують отримані залежності: у всіх випадках коефіцієнти детермінації *R*2 перевищують 0,999. Це, в свою чергу, свідчить про доцільність застосування вибраної апроксимаційної формули (3.1).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| Рис.3.1 Результати моделювання кінетики змін напруги розімкнутого кола (а), густини струму короткого замикання (б), питомої максимальної вихідної потужності (в) та коефіцієнта форми (г) в результаті утворення пар FeB. Різні за формою точки відповідають різним ступеням початкової дисоціації пар. Точки – результати моделювання, лінії – апроксимація за формулою (3.1) | |

Кількісні результати апроксимації зведені в табл.3.1. Зауважимо, що в ній для скорочення наведено значення модулів амплітуд змін параметрів: самі вони всі є від’ємними величинами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табл.3.1 Результати апроксимації моделюваних кінетичних залежностей фотоелектричних параметрів відповідно до формули (3.1) | | | | | | | | | | | | | |
| *N*Fe,tot, см-3 | η | Параметр | | | | | | | | | | | |
| Voc | | | Jsc | | | Pm | | | FF | | |
| |АVoc|, мВ | τVoc, c | Voc,eq, B | |АIsc|, мА⋅  см-2 | τIsc, c | Ιsc,eq, мА⋅  см-2 | |АPm|, мкВт⋅  см-2 | τPm, c | Pm,eq, мкВт⋅  см-2 | |АFF|, % | τFF, c | FFeq, % |
| 1011 | 0,2 | 1,37 | 579 | 0,376 | 3,39 | 591 | 583 | 2,31 | 599 | 161 | 0,363 | 618 | 73,4 |
| 0,4 | 2,80 | 572 | 0,376 | 6,68 | 597 | 583 | 4,47 | 611 | 161 | 0,670 | 652 | 73,4 |
| 0,6 | 4,26 | 568 | 0,376 | 9,87 | 602 | 583 | 6,50 | 623 | 161 | 0,932 | 688 | 73,4 |
| 0,8 | 5,76 | 564 | 0,376 | 13,0 | 608 | 583 | 8,47 | 628 | 161 | 1,18 | 704 | 73,4 |
| 1,0 | 7,30 | 560 | 0,376 | 16,0 | 613 | 583 | 10,3 | 637 | 161 | 1,38 | 737 | 73,4 |
| 1012 | 0,2 | 3,11 | 613 | 0,329 | 10,4 | 609 | 489 | 3,82 | 614 | 115 | 0,201 | 617 | 71,3 |
| 0,4 | 5,84 | 638 | 0,329 | 19,7 | 631 | 489 | 7,15 | 640 | 115 | 0,376 | 640 | 71,3 |
| 0,6 | 8,26 | 662 | 0,329 | 28,0 | 652 | 489 | 10,2 | 658 | 115 | 0,586 | 585 | 71,3 |
| 0,8 | 10,5 | 681 | 0,329 | 35,6 | 672 | 489 | 12,9 | 683 | 115 | 0,744 | 631 | 71,3 |
| 1,0 | 12,5 | 699 | 0,329 | 42,6 | 691 | 490 | 15,3 | 707 | 115 | 0,864 | 684 | 71,3 |
| 1013 | 0,2 | 3,58 | 609 | 0,283 | 12,9 | 614 | 332 | 3,51 | 617 | 64 | 0,26 | 612 | 68,3 |
| 0,4 | 6,85 | 623 | 0,283 | 24,2 | 640 | 332 | 6,57 | 640 | 64 | 0,53 | 559 | 68,3 |
| 0,6 | 9,75 | 648 | 0,283 | 34,2 | 665 | 332 | 9,23 | 670 | 64 | 0,76 | 602 | 68,3 |
| 0,8 | 12,4 | 672 | 0,283 | 43,1 | 689 | 332 | 11,6 | 699 | 64 | 0,95 | 652 | 68,3 |
| 1,0 | 14,5 | 693 | 0,283 | 51,2 | 711 | 332 | 13,7 | 727 | 64 | 1,12 | 685 | 68,3 |
| 1014 | 0,2 | 4,59 | 614 | 0,227 | 9,98 | 622 | 171 | 2,04 | 624 | 24,4 | 0,40 | 585 | 62,9 |
| 0,4 | 8,64 | 635 | 0,227 | 18,4 | 655 | 171 | 3,77 | 655 | 24,4 | 0,89 | 548 | 62,9 |
| 0,6 | 12,4 | 649 | 0,227 | 25,6 | 687 | 171 | 5,21 | 694 | 24,4 | 1,22 | 623 | 62,9 |
| 0,8 | 15,8 | 668 | 0,227 | 31,2 | 717 | 171 | 6,46 | 730 | 24,5 | 1,53 | 672 | 63,0 |
| 1,0 | 18,9 | 687 | 0,227 | 37,6 | 746 | 171 | 7,57 | 761 | 24,5 | 1,87 | 666 | 63,0 |

## 3.2 Результати експериментального дослідження

# Висновки

1. Розроблена методика проведення лабораторної роботи, спрямованої на вимірювання вольт-амперних характеристик з використанням мікроконтролерної плати Arduino. Проведено підбір необхідних елементів, а саме визначено доцільність використання цифро-аналогового перетворювача MCP4725 та монітору INA226.

2. Підготовлена програма для мікроконтролера та виготовлено прототип лабораторної роботи.

3. Створено опис роботи та проведено тестування обладнання.

# Список використаних джерел

[1]

[1] Burgelman M. Modelling polycrystalline semiconductor solar cells / M. Burgelman, P. Nollet, S. Degrave // Thin Solid Films. – 2000. – Vol. 361‑362. – P. 527‑532.

[4] O'Mara W.C. Handbook of semiconductor silicon technology / W.C. O'Mara, R.B. Herring, L.P. Hant. – New Jersey, USA: Noyes Publications, 1990. – 795 р.

[5] Green M. A. Intrinsic concentration, effective densities of states, and effective mass in silicon / M.A. Green // J. Appl. Phys.. – 1990. – Vol. 67. – P. 2944‑2954.

[6] Passler R. Dispersion-related description of temperature dependencies of band gaps in semiconductors / R. Passler // Phys. Rev. B. – 2002. – Vol. 66. – P. 085201.

[7] Yan D. Empirical determination of the energy band gap narrowing in p+ silicon heavily doped with boron / D. Yan, A. Cuevas // Phys. Rev. B. – 2014. – Vol. 116. – P. 194505.

[8] Couderc R. Reassessment of the intrinsic carrier density temperature dependence in crystalline silicon / R. Couderc, M. Amara, M. Lemiti // J. Appl. Phys. – 2014. – Vol. 115. – P. 093705.

[9] Klaassen D.B.M. A unified mobility model for device simulation ‑ I. Model equations and concentration dependence / D.B.M. Klaassen // Solid-State Electron. – 1992. – Vol. 35. – P. 953‑959.

[12] Rougieux, F. E. Determining the charge states and capture mechanisms of defects in silicon through accurate recombination analyses: A review / F. E. Rougieux, C. Sun, D. Macdonald // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. — 2018. — Vol. 187. — P. 263–272.

[13] The eﬀect of oxide precipitates on minority carrier lifetime in p–type silicon / J. D. Murphy, K. Bothe, M. Olmo et al. // J. Appl. Phys. — 2011. — Vol. 110 — P. 053713.

[14] Wijaranakula, W. The Reaction Kinetics of Iron–Boron Pair Formation and Dissociation in P–Type Silicon / W. Wijaranakula // J. Electrochem. Soc. —1993. — Vol. 140. — P. 275–281.

[15] Iron-boron pairing kinetics in illuminated p-type and in boron/phosphorus co-doped n-type silicon / C. Moller, T. Bartel, F. Gibaja, K. Lauer // J. Appl. Phys. — 2014. — Vol. 116. — P. 024503.

[16] Dissociation and Formation Kinetics of Iron–Boron Pairs in Silicon after Phosphorus Implantation Gettering / N. Khelifati, H.S. Laine, V. Vahanissi et al. // Phys Status Solidi A. — 2019. — Vol. 216. — P. 1900253.